

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0303U001217

Державний реєстраційний номер: 0102U005882

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-02-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Удосконалення устаткування для обробки великогабаритних полікристалічних заготівель.
Розробка нових технологій виготовлення полікристалічних блоків для великогабаритних сцинтиляторів.

Початок етапу: 01.2002

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-дослідне відділення лужногалоїдних кристалів НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 23756522

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0572)30-79-06, 30-83-45

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Амкрис Єйч ЛТД

Код за ЄДРПОУ: 19342985

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 321112

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Технопарк "Інститут монокристалів"

Код за ЄДРПОУ: 30954664

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Держадміністрація

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 30-79-73

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технології виготовлення полікристалічних блоків для великогабаритних сцинтиляторів.

Назва роботи англійською:

Polycrystalline blocks production technology for large scintillators.

Реферат українською:

Розроблено технологію виготовлення полікристалічних блоків високої якості для сцинтиляційних пластин великої площі, які використовуються у детекторах-екранах гамма-камер сучасного покоління. Розроблено вимоги до якості вихідних кристалічних заготовель призначених для деформування, а саме, висока оптична однорідність, тобто відсутність сторонніх включень і міхурів, а також фізична цілісність, тобто відсутність тріщин і сколов у всьому обсязі заготівлі.

Реферат англійською:

We worked out technology of high quality polycrystalline blocks production for large scintillation plates that are used in detector-shields of gamma-cameras of current generation. We worked out requirements of quality for crystalline blank parts that are meant for deforming, namely: high optical uniformity i.e. absence of foreign particulates and bubbles and physical integrity i.e. absence of cracks and chips in the whole blank part.5635

Індекс УДК: 661:548.55; 661.539.1.074; 661.143, 539.1.074.3:[548.5:546.33'15]

Коди тематичних рубрик: 61.69.37

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Шляхтуров В.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Шишкін О.В.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

